ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR

AO4803A

30V Dual P-Channel MOSFET

General Description

The AO4803A uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$ with low gate charge. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications.

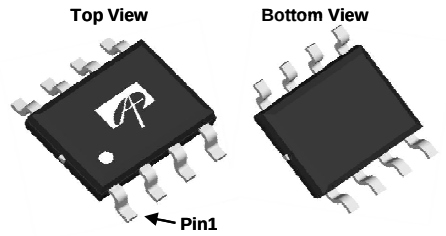
Product Summary

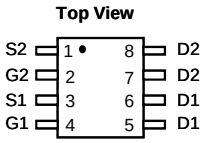
V_{DS}	-30V
I_D (at V_{GS}=-10V)	-5A
$R_{DS(ON)}$ (at V_{GS}=-10V)	< 46mΩ
$R_{DS(ON)}$ (at V_{GS} = -4.5V)	< 74mΩ

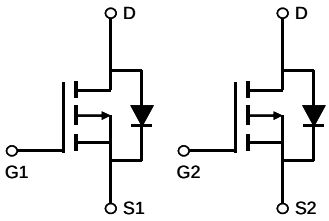
100% UIS Tested
100% R_g Tested

Green Product

SOIC-8







Absolute Maximum Ratings T_A=25°C unless otherwise noted

Parameter		Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage		V_{DS}	-30	V
Gate-Source Voltage		V_{GS}	±20	V
Continuous Drain Current	T_A=25°C	I_D	-5	A
	T_A=70°C		-4	
Pulsed Drain Current [C]		I_{DM}	-30	
Avalanche Current [C]		I_{AS}, I_{AR}	17	A
Avalanche energy L=0.1mH [C]		E_{AS}, E_{AR}	14	mJ
Power Dissipation [B]	T_A=25°C	P_D	2	W
	T_A=70°C		1.3	
Junction and Storage Temperature Range		T_J, T_{STG}	-55 to 150	°C

Thermal Characteristics

Parameter		Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient [A]	t ≤ 10s	$R_{\theta JA}$	48	62.5	°C/W
Maximum Junction-to-Ambient [A D]	Steady-State		74	110	°C/W
Maximum Junction-to-Lead	Steady-State	$R_{\theta JL}$	35	40	°C/W

Electrical Characteristics (T_J=25°C unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
STATIC PARAMETERS						
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	I_D=-250µA, V_{GS}=0V	-30			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V_{DS}=-30V, V_{GS}=0V			-1	µA
		T_J=55°C			-5	
I_{GSS}	Gate-Body leakage current	V_{DS}=0V, V_{GS}= ±20V			±100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	V_{DS}=V_{GS} I_D=-250µA	-1.5	-2	-2.5	V
$I_{D(ON)}$	On state drain current	V_{GS}=-10V, V_{DS}=-5V	-30			A
$R_{DS(ON)}$	Static Drain-Source On-Resistance	V_{GS}=-10V, I_D=-5A		32	46	mΩ
		T_J=125°C		48	68	
		V_{GS}=-4.5V, I_D=-4A		51	74	mΩ
g_{FS}	Forward Transconductance	V_{DS}=-5V, I_D=-5A		13		S
V_{SD}	Diode Forward Voltage	I_S=-1A,V_{GS}=0V		-0.7	-1	V
I_S	Maximum Body-Diode Continuous Current				-2.5	A
DYNAMIC PARAMETERS						
C_{iss}	Input Capacitance	V_{GS}=0V, V_{DS}=-15V, f=1MHz		520		pF
C_{oss}	Output Capacitance			100		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			65		pF
R_g	Gate resistance	V_{GS}=0V, V_{DS}=0V, f=1MHz	3.5	7.5	11.5	Ω
SWITCHING PARAMETERS						
Q_g(10V)	Total Gate Charge	V_{GS}=-10V, V_{DS}=-15V, I_D=-5A		9.2	11	nC
Q_g(4.5V)	Total Gate Charge			4.6	6	nC
Q_{gs}	Gate Source Charge			1.6		nC
Q_{gd}	Gate Drain Charge			2.2		nC
$t_{D(on)}$	Turn-On DelayTime	V_{GS}=-10V, V_{DS}=-15V, R_L=3Ω, R_{GEN}=3Ω		7.5		ns
t_r	Turn-On Rise Time			5.5		ns
$t_{D(off)}$	Turn-Off DelayTime			19		ns
t_f	Turn-Off Fall Time			7		ns
t_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Time	I_F=-5A, dI/dt=100A/µs		11		ns
Q_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Charge	I_F=-5A, dI/dt=100A/µs		5.3		nC

A. The value of $R_{\theta JA}$ is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with T_A =25° C. The value in any given application depends on the user's specific board design.
B. The power dissipation P_D is based on $T_{J(MAX)}$=150° C, using ≤ 10s junction-to-ambient thermal resistance.
C. Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature $T_{J(MAX)}$=150° C. Ratings are based on low frequency and duty cycles to keep initialT_J=25° C.
D. The $R_{\theta JA}$ is the sum of the thermal impedence from junction to lead $R_{\theta JL}$ and lead to ambient.
E. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using <300µs pulses, duty cycle 0.5% max.
F. These curves are based on the junction-to-ambient thermal impedence which is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, assuming a maximum junction temperature of $T_{J(MAX)}$=150° C. The SOA curve provides a single pulse rating.

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

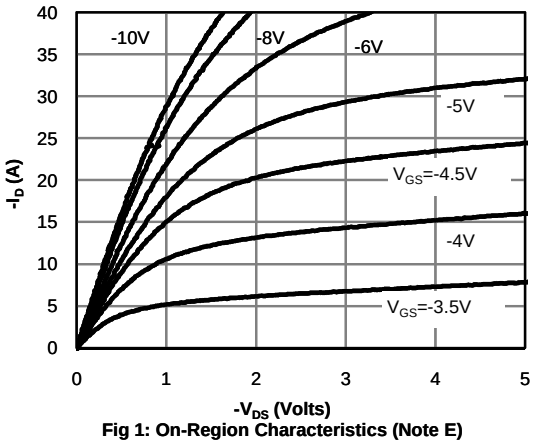


Fig 1: On-Region Characteristics (Note E)

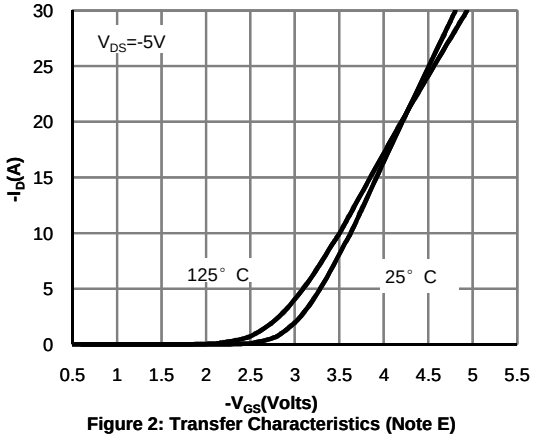


Figure 2: Transfer Characteristics (Note E)

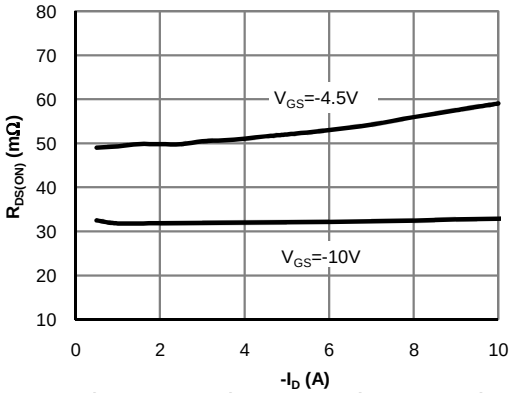


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage (Note E)

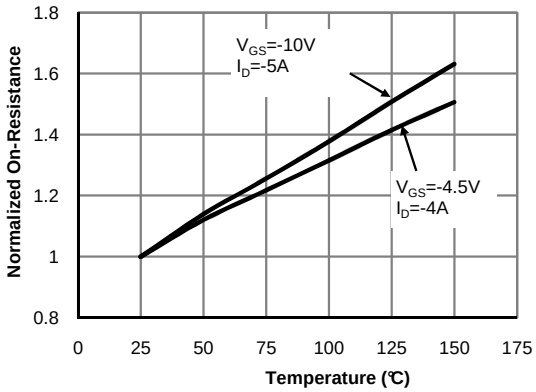


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature (Note E)

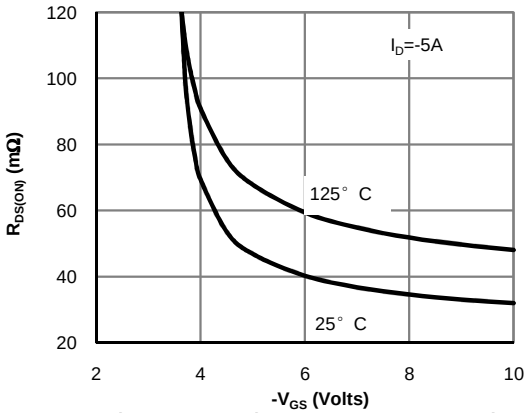


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage (Note E)

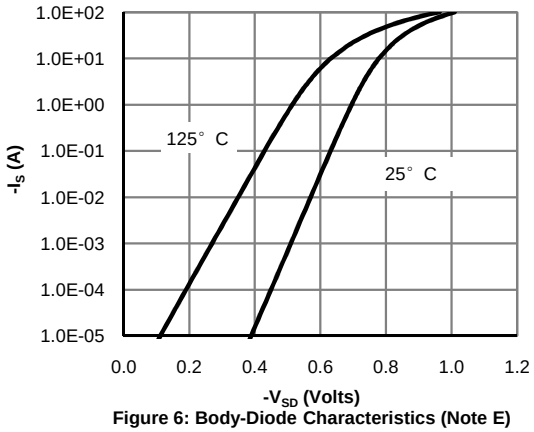


Figure 6: Body-Diode Characteristics (Note E)

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

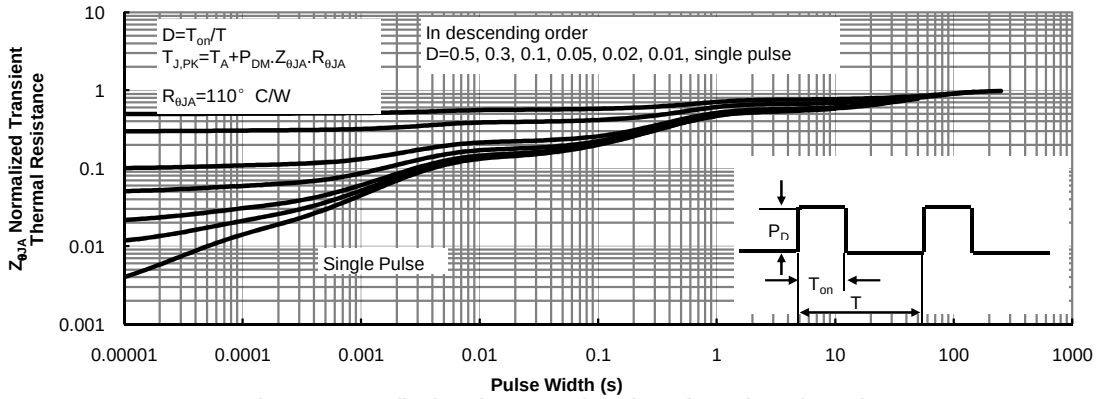


Figure 12: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

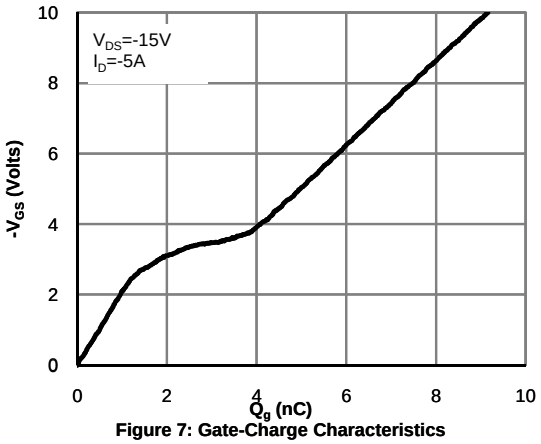


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

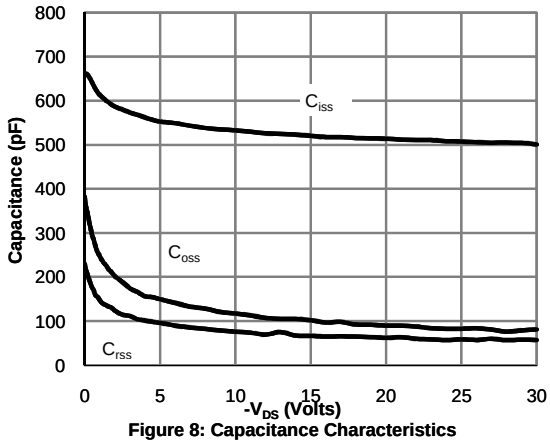


Figure 8: Capacitance Characteristics

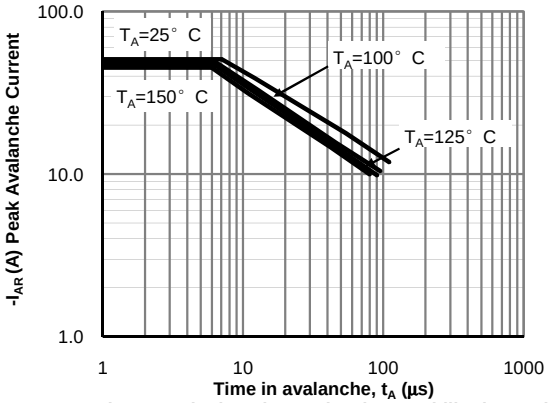


Figure 9: Single Pulse Avalanche capability (Note C)

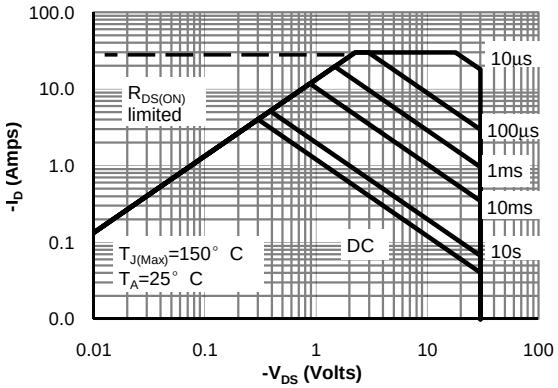


Figure 10: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note F)

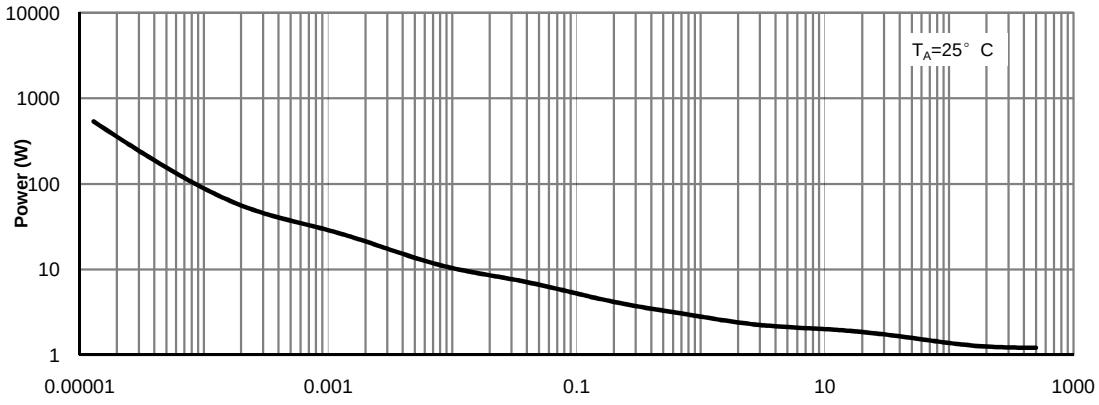
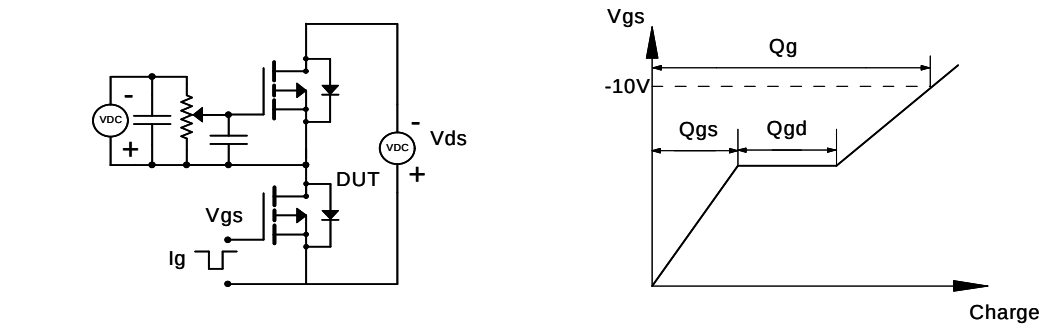
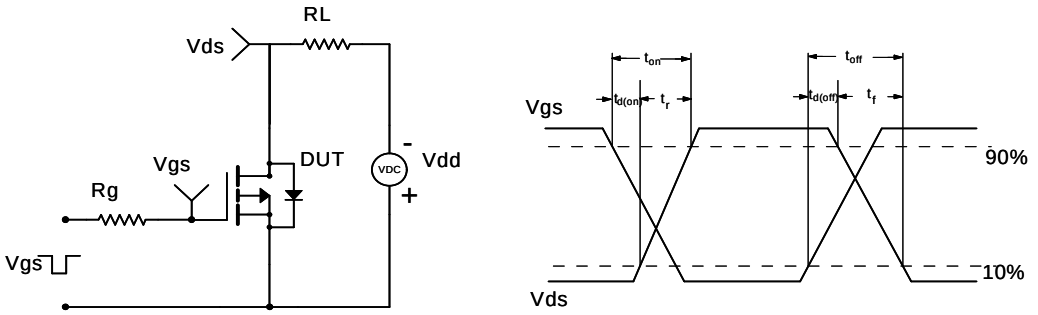


Figure 11: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note F)

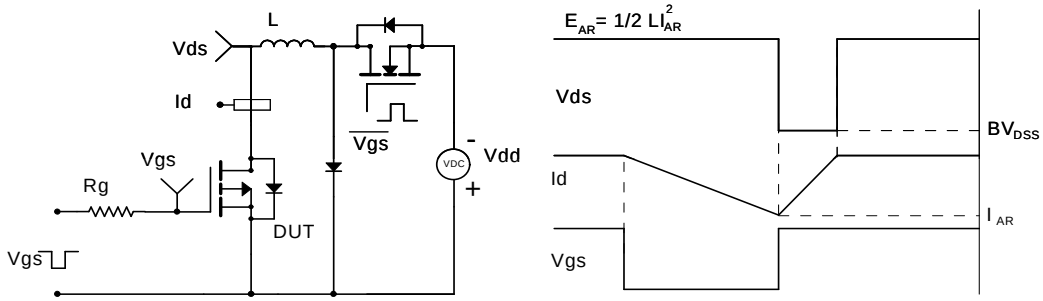
Gate Charge Test Circuit & Waveform



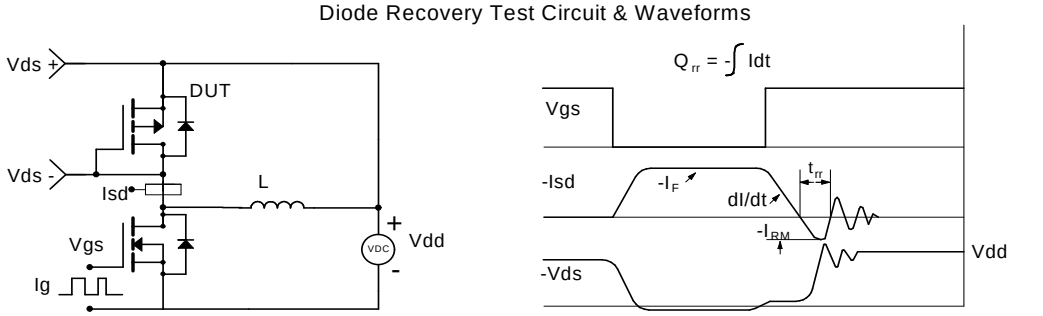
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching (UIS) Test Circuit & Waveforms



Diode Recovery Test Circuit & Waveforms



OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А